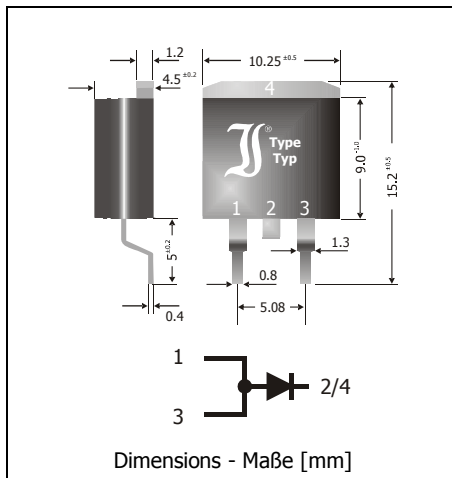


S15AYD2 ... S15MYD2

Surface Mount Silicon Rectifier Diodes – Single Diode Silizium-Gleichrichterdioden für die Oberflächenmontage– Einzeldiode

Version 2013-02-27



Nominal current Nennstrom	15 A
Repetitive peak reverse voltage Periodische Spitzensperrspannung	50...1000 V
Plastic case Kunststoffgehäuse	TO-263AB D ² PAK
Weight approx. Gewicht ca.	1.6 g
Plastic material has UL classification 94V-0 Gehäusematerial UL94V-0 klassifiziert	
Standard packaging in tubes Standard Lieferform in Stangen	



Maximum ratings and Characteristics

Grenz- und Kennwerte

Type Typ	Repetitive peak reverse voltage Periodische Spitzensperrspannung V_{RRM} [V] ¹⁾	Surge peak reverse voltage Stoßspitzensperrspannung V_{RSM} [V] ¹⁾	Forward voltage Durchlass-Spannung V_F [V] $T_j = 25^\circ\text{C}$	
			$I_F = 5\text{ A}$	$I_F = 15\text{ A}$
S15AYD2	50	50	< 1.0	< 1.3
S15BYD2	100	100	< 1.0	< 1.3
S15DYD2	200	200	< 1.0	< 1.3
S15GYD2	400	400	< 1.0	< 1.3
S15JYD2	600	600	< 1.0	< 1.3
S15KYD2	800	800	< 1.0	< 1.3
S15MYD2	1000	1000	< 1.0	< 1.3

Max. average forward current, R-load Dauergrenzstrom mit R-Last	$T_C = 100^\circ\text{C}$	I_{FAV}	15 A
Repetitive peak forward current Periodischer Spitzenstrom	$f > 15\text{ Hz}$	I_{FRM}	50 A ¹⁾
Peak forward surge current, 50/60 Hz half sine-wave Stoßstrom für eine 50/60 Hz Sinus-Halbwelle	$T_A = 25^\circ\text{C}$	I_{FSM}	250/275 A ¹⁾
Rating for fusing, $t < 10\text{ ms}$ Grenzlastintegral, $t < 10\text{ ms}$	$T_A = 25^\circ\text{C}$	i^2t	312 A ² s ¹⁾
Junction temperature – Sperrschichttemperatur Storage temperature – Lagerungstemperatur		T_j T_s	-50...+150°C -50...+175°C

1 Max. temperature of the case $T_C = 100^\circ\text{C}$ – Max. Temperatur des Gehäuses $T_C = 100^\circ\text{C}$

Characteristics

Kennwerte

Leakage current Sperrstrom	$T_j = 25^\circ\text{C}$ $V_R = V_{RRM}$ $T_j = 125^\circ\text{C}$ $V_R = V_{RRM}$	I_R I_R	< 10 μA < 100 μA
Thermal resistance junction to case Wärmewiderstand Sperrschicht – Gehäuse		R_{thC}	< 2.1 K/W

